

**平成22年度（2010年度）第2回
電界計測に基づく非破壊評価応用研究会**

本年度第2回研究会を下記にて開催いたします。今回は研究室見学と3件の講演を予定致しておりますので、奮ってご参加お願い申し上げます。

記

1. 日 時：2010年11月26日（金）13：30～16：30

2. 場 所：名古屋大学（東山キャンパス）

大学院工学研究科2号館346室（航空小会議室）

アクセス <http://www.nagoya-u.ac.jp/global-info/access-map/access/>

東山キャンパス <http://www.nagoya-u.ac.jp/global-info/access-map/higashiyama/>

3. 議 題

(1) 主査挨拶 日立建機（株） 山本 弘

(2) 講演

「GaAs 半導体材料の導電率の非接触計測」

名古屋大学 巨 陽

「周波数掃引渦電流法による無電界ニッケルメッキ層の硬さ評価」

神奈川県産業技術センター 小島 隆

「電位差法による配管肉厚測定の精度評価」

東京電力(株) 海江田 理

(3) 研究室見学 （15：30～16：30）

(4) その他

次回の研究会について

4. 参加要領：研究会への参加は無料です。今回は、交流会を計画いたしておりますので、研究会及び交流会への出席を11月19日（金）までに、以下に連絡いただきますようお願い申し上げます。

5. 問い合わせ先：(社) 日本非破壊検査協会 学術課 担当：岡

Tel:03-5821-5105 Fax:03-3863-6524

E-mail:oka@jsndi.or.jp

※都合により、予告しました内容から若干の変更をすることがあります。また、交流会（交流会は参加実費(5,000円程度)を当日徴収させていただきます）を研究会終了後、別会場にて計画いたしております。

以上

